

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
Факультет естественно-научного и гуманитарного образования
Кафедра «Физика»
Научно-образовательный центр нанотехнологий «ОрёлНано»

**VIII региональный семинар
«Компьютерное моделирование и проектирование
микро- и нанoeлектроники и микроэлектромеханических систем.
МНЭиМС-2016»**

29-го апреля 2016 года. Начало в 10:00

Место проведения: г. Орёл, Наугорское шоссе 29 (бывший Главный корпус ОрелГТУ)
2 этаж, аудитория 212

Председатель Оргкомитета	Матюхин Сергей Иванович - Декан Факультета естественно-научного и гуманитарного образования (ФЕНГО), д.ф.-м.н. matyukhin@ostu.ru
Зам. председателя	Турин Валентин Олегович - Зав. Кафедрой «Физика» ФЕНГО, к.ф.-м.н. voturin@ostu.ru
Ученый секретарь	Шадрин Иван Фёдорович - Доцент кафедры «Физика» ФЕНГО, к.ф.-м.н. ivshadr@mail.ru
Члены Оргкомитета	Мишин Владислав Владимирович - Зав. кафедрой «Электроника, вычислительная техника и информационная безопасность», к.т.н. evtib603@ostu.ru Марков Олег Иванович - Зав. кафедрой «Физика» Физико-математического факультета, д.ф.-м.н. O.I.Markov@mail.ru Аксёнов Игорь Владимирович - Технический директор АО «Протон». aksenov@proton-orel.ru Цырлов Андрей Михайлович - Начальник СКТБ «Оптрон» АО «Протон», к.т.н. sktp@proton-orel.ru Ставцев Александр Валерьевич - Технический директор ЗАО «Протон-Электротекс». a.stavtsev@proton-electrotex.com Кшенский Олег Николаевич - Главный инженер СКТБ ЗАО «Болховский завод полупроводниковых приборов», к.т.н. oaobzpp@list.ru Моисеев Павел Петрович - Директор ООО «НПП «Астрон Электроника». moiseev_pp@pochta.ru

Контакты:

Телефоны: +7(920)8250040

Факс: +7(4862)416684

E-mail: voturin@ostu.ru (Турин Валентин Олегович)

Программа семинара МНЭиМС-2016*

- 10:00-10:05 Матюхин С.И.
«Приветствие к участникам семинара»
Декан ФЕНГО, ОГУ имени И.С. Тургенева
- 10:05-10:15 Писарев А.А.¹, Матюхин С.И.²
«Разработка пакета компьютерных программ для автоматизированного проектирования силовых полупроводниковых приборов»
¹ЗАО «Протон-Электротекс», ²ОГУ имени И.С. Тургенева
- 10:15-10:30 Малый Д.О.¹, Вишняков А.С.¹, Матюхин С.И.²
«Моделирование термомеханических деформаций силового полупроводникового модуля паяной конструкции»
¹ЗАО «Протон-Электротекс», ²ОГУ имени И.С. Тургенева
- 10:30-10:45 Титушкин В.А.¹, Матюхин С.И.²
«Оптимизация силовых полупроводниковых приборов посредством моделирования остаточных изгибов и термомеханических напряжений в полупроводниковых структурах»
¹ЗАО «Протон-Электротекс», ²ОГУ имени И.С. Тургенева
- 10:45-11:00 Вишняков А.С.¹, Малый Д.О.¹, Матюхин С.И.²
«Моделирование тепловых характеристик силового полупроводникового модуля паяной конструкции»
¹ЗАО «Протон-Электротекс», ²ОГУ имени И.С. Тургенева
- 11:00-11:30 Кофе-брейк
- 11:30-11:45 Поярков В.Н., Шкарлат Р.С., Кшенский О.Н.
«Оценка чистоты оксидных плёнок на поверхности кремния с помощью измерения вольт-фарадной характеристики системы»
ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов»
- 11:45-12:00 Рогов А.П.¹, Турин В.О.¹, Цырлов А.М.²
«Приборно-технологическое моделирование технологии изготовления кремниевого ДМОП транзистора»
¹ОГУ имени И.С. Тургенева, ²АО «Протон»
- 12:00-12:15 Турин В.О.
«Теплоотвод через пассивацию и подложку от точечного и линейного источников тепла, расположенных в слое полупроводника»
ОГУ имени И.С. Тургенева
- 12:15-12:30 Рахматов Б.А.¹, Турин В.О.¹, Ким Ч.²
«Уравнение для тока стока органического полевого транзистора с корректным учетом ненулевой дифференциальной проводимости в режиме насыщения»
¹ОГУ имени И.С. Тургенева, ²Gwangju Institute of Science, Republic of Korea
- 12:30-12:40 Кофе-брейк
- 12:40-13:00 Стендовые доклады
1. Марков О.И. «Моделирование ветви термоэлемента с теплообменом излучением». ОГУ имени И.С. Тургенева.
 2. Шадрин И.Ф. «Формирование ограниченных кластеров из нанотрубок». ОГУ имени И.С. Тургенева.

3. Кильчицкая М.В., Герасимов К.А., Панченко П.В. «Полупроводниковое производство ЗАО «Группа Кремний ЭЛ». ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
4. Гришин В.Д. «Атомно-силовая микроскопия поверхности кварцита». ОГУ имени И.С. Тургенева.
5. Невров И.А., Шкарлат Р.С., Турин В.О. «Расчет статического коэффициента усиления мощного биполярного транзистора». ОГУ имени И.С. Тургенева.
6. Матвеев Д.А., Петрухин А.Д., Заночкин Е.А. Турин В.О. «Физические основы моделирования температурной зависимости концентрации электронов и дырок в полупроводниках с учетом сложного состава легирования и статистики Ферми-Дирака». ОГУ имени И.С. Тургенева.
7. Рогов А.П.¹, Турин В.О.¹, Цырлов А.М.², А.С. Студенников², Головкин Н.В.³ «Компактное моделирование кремниевого вертикального ДМОП-транзистора на Verilog-A в САПР Synica». ¹ОГУ имени И.С. Тургенева. ²АО «Протон», ³Филиал ФГБУ «46 ЦНИИ»
8. Петрухин А.Д., Заночкин Е.А., Матюхин С.И. «Моделирование ВАХ силовых диодов в программной среде Comsol Multiphysics». ОГУ имени И.С. Тургенева.
9. Заночкин Е.А., Петрухин А.Д., Матюхин С.И. «Моделирование деформаций, обусловленных нагреванием и охлаждением полупроводникового модуля паяной конструкции». ОГУ имени И.С. Тургенева.
10. Капустин М.И., Костына К.В., Турин В.О. «Уточнение распределения концентрации электронов и дырок в простейшей модели р-п перехода». ОГУ имени И.С. Тургенева.

Выставка

1. АО «Протон», г. Орёл.
2. ЗАО «Протон-Электротекс», г. Орёл.
3. ОАО «БЗПП», г. Болхов.
4. Госуниверситет-УНПК. Стенд «Литература по микроэлектронике».

13:00-14:00 Обед

14:00-15:00 Круглый стол, посвящённый обсуждению результатов семинара и перспективам развития сотрудничества между вузами, предприятиями электронной промышленности и компаниями, разработчиками микро- и нанoeлектронных САПР.

*В программу могут быть внесены изменения